PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-259940

(43) Date of publication of application: 08.10.1996

(51)Int.Cl.

CO9K 11/06 HO5B 33/14

(21)Application number: 08-049045

(71)Applicant: EASTMAN KODAK CO

(22)Date of filing:

06.03.1996

(72)Inventor: SHI JIANMIN

CHEN CHIN H

VAN SLYKE STEVEN A

TANG CHING W

(30)Priority

Priority number: 95 401102

Priority date: 08.03.1995

Priority country: US

(54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DEVICE WITH HIGH THERMAL STABILITY

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an org. electroluminescent device with an improved thermal stability by using a hole transport layer contg. a specific arom. polyamine having a glass transition point of 100° C or higher.

SOLUTION: In the org. electroluminescent device having an anode, a cathode, and an electroluminescent element held between the anode and cathode, the element has at least one hole transport layer contg. an arom. polyamine which has a glass transition point (Tg) of 100° C or higher and has a poly-substituted anilinobenzene molecular structure having 3 or more amine parts bonded to a single molecule, an example being represented by the formula (wherein R1 and R2 are each an alkyl or optionally substd. aryl; R is H, an alkyl, or optionally substd. phenyl; and n is 3-6).

$$R_{(6-n)}$$

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-259940

(43)公開日 平成8年(1996)10月8日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C09K 11/06

H 0 5 B 33/14

9280-4H

C09K 11/06 H 0 5 B 33/14 Z

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 17 頁)

(21)出願番号

特願平8-49045

(22)出顧日

平成8年(1996)3月6日

(31)優先権主張番号 401102

(32)優先日

1995年3月8日

(33)優先権主張国

米国(US)

(71)出願人 590000846

イーストマン コダック カンパニー アメリカ合衆国, ニューヨーク14650, ロ チェスター, ステイト ストリート343

(72) 発明者 ジアンミン シー

アメリカ合衆国, ニューヨーク 14580,

ウェブスター、グラウス・ポイント 34

(72)発明者 チン エイチ チェン

アメリカ合衆国, ニューヨーク 14506,

メンドン、シャトー・プレイス 6

(74)代理人 弁理士 伊東 忠彦 (外1名)

最終頁に続く

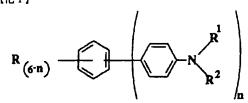
(54) 【発明の名称】 高い熱安定性を有する有機エレクトロルミネセンス装置

(57)【要約】

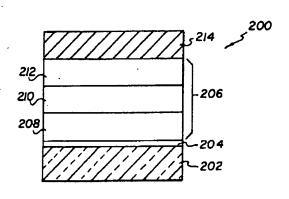
【課題】 本発明は向上された熱安定性を有する有機 E L装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 陽極と、陰極と、前記陽極と陰極との間 に配置されたエレクトロルミネセンス素子とを備えた有 機工レクトロルミネセンス装置が開示されている。有機 エレクトロルミネセンス素子は少なくとも1の正孔移動 層を有している。正孔移動層は一般式





(式中、nは3、4、5又は6に等しく、R1 はアルキ ル、アリール及び置換アリールからなる群から選択さ れ、R² はアルキル、アリール及び置換アリールからな る群から選択され、そして、Rは水素及びアルキルから なる群から選択される)のポリ芳香族アミンを含む。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 陽極と、陰極と、前記陽極と陰極との間 に配置されたエレクトロルミネセンス素子とを備えた有 機エレクトロルミネセンス装置において、

前記有機エレクトロルミネセンス素子は少なくとも1の 正孔移動層を有し、

前記正孔移動層は前記正孔移動層のため100℃以上の ガラス転移温度 (Tg) を有するポリ芳香族アミンを含 み、前記ポリ芳香族アミンは単一分子で結合した3又は それ以上のアミン部分を有するポリ置換アニリノベンゼ 10 ン分子構造を有することを特徴とする有機エレクトロル ミネセンス装置。

【請求項2】 陽極と、陰極と、前記陽極と陰極との間 に配置されたエレクトロルミネセンス素子とを備えた有 機工レクトロルミネセンス装置において、

前記有機エレクトロルミネセンス素子は少なくとも1の 正孔移動層を有し、

前記正孔移動層は一般式

(化1)

$$R_{(6-n)}$$

(式中、nは3、4、5又は6に等しく、

R1 はアルキル、アリール及び置換アリールからなる群 から選択され、

R² はアルキル、アリール及び置換アリールからなる群 から選択され、

そして、Rは水素及びアルキルからなる群から選択され る) のポリ芳香族アミンを含むことを特徴とする有機工 レクトロルミネセンス装置。

【請求項3】 n=3である請求項2記載の有機エレク トロルミネセンス装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は有機エレクトロルミ ネセンス装置に関するものである。本発明は、より詳細 には、導電性有機層から発光し高い熱安定性を有する装 40 置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】有機エレクトロルミネセンス装置はおよ そ20年間に亘って知られる一方で、その性能的限界が 多くの所望される適用に対する壁となってきた(以後、 エレクトロルミネセンスの一般的頭文字であるELを時 に簡潔性のために使用することとする)。

【0003】初期の有機EL装置の代表的なものには、 1965年3月9日に特許権を与えられたガーニー(Gur nee) 等の米国特許第3172862号、1965年3月 50 族第三アミン層に置き換えることにより発光における劇

9日に特許権を与えられたガーニーの米国特許第317 3050号、ドレスナー(Dresner) による"Double Inje ction Electroluminescence in Anthracene", RCA Revi ew, Vol. 30, pp. 322-334, 1969、及び1973年1月9 日に特許権を与えられたドレスナーの米国特許第371 0167号に記載されたものがある。その有機発光物質 は共役有機ホスト(host)物質及び縮合ペンゼン環を有す る共役有機活性剤から形成されていた。有機ホスト物質 の例として、ナフタレン、アントラセン、フェナントレ ン、ピレン、ペンゾピレン、クリセン、ピセン、カルバ ゾール、フルオロレン、ピフェニル、テルフェニル、ク オーターフェニル、トリフェニレンオキシド、ジハロビ フェニル、トランスースチルペン、及び1, 4ージフェ ニルプタジエンが挙げられている。アントラセン、テト ラセン、及びペンタセンが活性剤の例として提供されて いる。有機発光物質は1mm以上の厚さを有する単一層 として存在するものであった。

【0004】有機EL装置の構造分野における最近の発 見は、一つが正孔を注入し移動させるために特に選択さ 20 れ、他の一方が電子を注入し移動させるために特に選択 され装置の有機ルミネセンス帯としても機能する、陰極 と陽極とを分離する二つの極薄層 (<1.0mm) より なる有機ルミネセンス媒体を有するEL装置構造からな された。その極薄有機ルミネセンス媒体では抵抗が減少 し、与えられたレベルの電気パイアスに対しより高い電 気密度を許容するものである。発光は有機ルミネセンス 媒体を通した電気密度に直接関係するものであるので、 増加された電荷注入及び移動効率と連結された薄層は、 **電界効果型トランジスター等の集積回路ドライバーに適** 30 合した範囲の低電圧において容認できる発光レベル(例 えば、周囲光の中で目視により検出可能な明るさのレベ ル)を有する。

【0005】例えば、タン(Tang)の米国特許第4356 429号は、ポルフィリン系化合物を含有する正孔注入 及び移動層並びに装置の発光帯としても機能する電子注 入及び移動層からなる有機ルミネセンス媒体から形成さ れるEL装置を開示している。実施例1においては、導 電性ガラス透明陽極、銅フタロシアニンの1000オン グストローム正孔注入及び移動層、装置のルミネセンス 帯としても機能するポリ(スチレン)中のテトラフェニ ルプタジエンの1000オングストローム電子注入及び 移動層、並びに銀陰極から形成される装置が開示されて いる。その装置は、30から40mA/cm2 の平均電 気密度で20ポルトの電圧をかけられた際に青色光を発 し、その明るさは5 c d/m² であった。

【0006】かかる有機EL装置の更なる改良はファン スライク(Van Slyke) 等による米国特許第453950 7号により教示されている。ファンスライク等はタンが 用いた正孔注入及び移動用ポルフィリン系化合物を芳香

的な改良を成した。その実施例1を参照するに、透明導 電性陽極上に750オングストロームの正孔注入及び移 動用1, 1-ビス(4-ジ-p- トリルアミノフェニル) シクロ ヘキサン並びに電子注入及び移動用4,4'-ピス(5,7-ジ-t - ペンチル-2- ペンゾオキサゾリル)-スチルベン層が真 空めっき蒸着され、後者はまた装置のルミネセンス帯を 提供する仕組になっている。インジウムが陰極として使 用されている。このEL装置は脊緑光(520nm)を 発し、その最高の明るさ340cd/m² は電気密度が およそ140mA/cm⁻²で電圧が22ポルトの時に達 10 成された。最大仕事変換効率は約1. 4×10-3 watt/ Wattであり最大Eし量子効率は20ポルトの時に約1. 2×10⁻²フォトン/電子であった。

【0007】様々な陰極材料を用いた有機EL装置が製 造されている。初期の段階ではそれらが最低の仕事関数 (work function) を有するということでアルカリ金属が 使用されていた。当業者により教示された他の陰極材料 は、黄銅、導電性金属酸化物(例えばインジウム錫酸化 物)、及び単一の低仕事関数(<4eV)金属の組み合 属であった。上述したガーニー等及びガーニーの特許 は、クロム、パス、銅、及び導電性ガラスによる電極を 開示している。ドレスナーの米国特許第3710167 号においては、厚さが10オングストローム未満の酸化 アルミニウム又は酸化硅素層に覆われた対応するアルミ ニウム又は縮重N・硅素からなるトンネル注入陰極が使 用されている。上述したタンは、低仕事関数を有するイ ンジウム、銀、錫、及びアルミニウム等の金属の単一物 から形成される有益な陰極を教示しており、一方、上述 したファンスライク等は、インジウム、銀、錫、鉛、マ 30 って更に高い光度レベルを達成することが可能になる。 グネシウム、マンガン及びアルミニウムの様々な単一金 属による陰極を開示している。

【0008】 タン等による米国特許第4885211号 は、そのうちの少なくとも1つが4eV未満の仕事関数 を有するアルカリ金属以外の複数の金属から形成される 陰極を包含するEL装置を開示している。よく引用され るファンスライク等の米国特許第4720432号は、 改良された多層有機媒体を使用したエレクトロルミネセ ンス装置を記述している。この特許に説明されるよう に、その有機ルミネセンス又はEL装置は直流電圧源、 交流(AC)電圧源、又はいかなる周期の電源によって も作動されることが可能である。このEL装置は、基本 的には電流を順方向パイアス電圧にのみ流すダイオード 整流器である。この電流がエレクトロルミネセンスを生 成するように有機媒体を励起する。バイアスが逆の場合 には、電流が遮断されてダイオードに入ることができ

ず、結果として発光は起こらない。

【0009】色合い、安定性、効率、及び製造方法等に おける有機エレクトロルミネセンス装置の更なる改良 は、米国特許第5151629号、5150006号、 5141671号、5073446号、5061569 号、5059862号、5059861号、50476 87号、4950950号、5104740号、522 7252号、5256945号、5069975号、及 び5122711号に開示されている。

[0010]

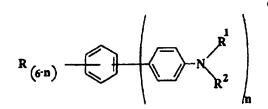
【発明が解決しようとする課題】これらの改良にも拘ら ず、真空蒸着させた有機フィルムの薄層を含有するEL 装置の熱安定性には未だ問題が存在している。熱不安定 性とは、温度の上昇に伴いEL装置がより早く劣化して しまうこと、又は室温より高いある温度で機能しなくな ることを意味する。この不安定性の原因は、EL装置に 使用される有機層の形態的変化であると考えられてい る。更にこの変化は、おそらくは最低の熱安定性を有す る有機層からであろうが、どの有機層からも始まる可能 わせを含むより高い仕事関数(4 e V以上)を有する金 20 性があり、結果として装置が全く機能できなくなってし まう。有機ELに関する先行技術によれば、一般的に1 00℃未満であるガラス転移温度により特徴付けられる 低分子量の芳香族アミンを基とする正孔移動物質が最も 熱不安定であることは明らかである。それ故、新しい分 子構造を設計することによりこのクラスの物質の熱安定 性を更に改良することは重要なことである。予想される 優位性はEL装置が髙温下で操作できることである。よ り高い熱分解域を有することによりEL装置はより大き な電流密度に耐えることができるようになり、それによ

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明の目的は向上され た熱安定性を有する有機EL装置を提供することであ る。。この目的は、陽極と、陰極と、前記陽極と陰極と の間に配置されたエレクトロルミネセンス素子とを備え た有機エレクトロルミネセンス装置において、前配有機 エレクトロルミネセンス素子は少なくとも1の正孔移動 層を有し、前記正孔移動層は前記正孔移動層のため10 O℃以上のガラス転移温度(Tg)を有するポリ芳香族 40 アミンを含み、前記ポリ芳香族アミンは単一分子に結合 した3又はそれ以上のアミン部分を有するポリ置換アニ リノベンゼン分子構造を有することを特徴とする有機工 レクトロルミネセンス装置により達成される。

[0012]

(化2)



【0013】 (式中、R'及びR'はアルキル、アリー ル又は置換アリール基の何れかであり、Rは水素、アル キル、フェニル又は置換フェニル基であり、nは3、 4、5又は6である。)

[0014]

【発明の実施の形態】図1には本発明によるエレクトロ ルミネセンス又はEL装置100の概略図が示されてい る。陽極102は、明示されているように3つの層から なる有機ルミネセンス媒体106により陰極104から 分離されている。陽極の上に位置する層108は有機ル ミネセンス媒体の正孔注入領域を形成する。その正孔注 入層の上に位置するのが、有機ルミネセンス媒体の正孔 移動領域を形成する層110である。正孔移動層及び陰 極の間に挟まれているのが有機ルミネセンス媒体の電子 注入及び移動領域を形成する層112である。陽極及び 陰極は、それぞれコンダクター116及び118により 外部AC又はDC電源に接続されている。電源はパルス であっても連続波(CW)であっても構わない。

【0015】陽極が陰極よりも高電位である場合には、 EL装置を順方向にパイアスされたダイオードとして見 ることができる。これらの条件下では、ルミネセンス媒 体において正孔(陽電荷担体)の注入は120に概略的 に示されるように下側有機層に向けて起こり、一方、電 子は122に概略的に示されるように上側有機層に向け 30 て注入される。注入された正孔及び電子は、それぞれ1 24及び126の矢印に示されるように逆の電荷を帯び た電極に向かって移動する。この結果、正孔-電子の再 結合が起こる。移動する電子がその導電電位から価電子 帯に落ちる際にエネルギーが光として放出される。従っ て、有機ルミネセンス媒体は両電極間にそれぞれの電極 からの移動電荷担体を受け入れるルミネセンス領域を形 成する。どの構造を選択するかによって、放出された光 を電極を分離している有機ルミネセンス媒体128の1 つ又はそれ以上の端を通して、陽極を通して、陰極を通 して、又はそれらの全ての組み合わせを通して、有機ル ミネセンス媒体から発光させることが可能である。

【0016】有機ルミネセンス媒体は非常に薄いもので あるので、通常は一方の電極又は両電極を通して発光す ることが好ましい。これは、有機ルミネセンス媒体或い は分離半透明又は透明媒体或いは分離半透明又は透明支 持体の何れかの上に半透明又は透明被膜として電極を形 成することにより達成される。被膜の厚さは光透過(又 は消光) 及び導電(又は抵抗)のパランスを保って決定 される。光透過性金属系電極を形成する際の実用的なバ 50 及び移動領域を形成している。

ランスは、典型的に50から250オングストロームの 範囲の厚さの導電性被膜により保たれる。電極が光を伝 えることを欲しない、又は電極が透明導電性金属酸化物 10 等の透明物質により形成されている場合には、製造に適 したそれ以上の厚さの全ての範囲を用いることができ

【0017】図2に示される有機EL装置200は本発 明の好ましい具体例を説明するものである。有機EL装 置の発展の経緯から、通常は透明陽極が使用される。こ れは、透明絶縁性支持体202の上に比較的高い仕事関 数を有する導電性光透過性金属又は金属酸化物層を堆積 させて陽極204を形成することにより達成される。有 機ルミネセンス媒体206並びにその層208、210 及び212は、それぞれ媒体106並びにその層10 8、110及び112に対応し、これ以上の説明は必要 としない。以下に記述される好ましい材料を選択するこ とにより形成される有機ルミネセンス媒体において、層 212は発光が起こる領域である。陰極214はその有 機ルミネセンス媒体の上層に堆積により都合良く形成さ れる。

【0018】図3に示される有機EL装置300は本発 明の他の好ましい具体例を説明するものである。有機E し装置の歴史的発達パターンとは反対に、装置300か らの発光は光透過性(例えば、透明又は実質的に透明) 陰極314を通して起こる。装置300の陽極は、装置 200と同様に形成することにより陽極及び陰極双方か らの発光を行ってもよいが、好ましい形態においては比 較的高い仕事関数を有する金属担体等の不透明電荷伝播 性素子を用いて陽極302を形成する。有機ルミネセン ス媒体306並びにその層308、310及び312 は、媒体106並びにその層108、110及び112 にそれぞれ対応し、これ以上の説明は必要としない。装 置200と装置300の間の大きな違いは、後者が有機 EL装置において慣習的に用いられる不透明陰極の代わ りに薄い光透過性(例えば、透明又は実質的に透明)陰 極を用い、殆どの場合に、通常使用される光透過性陽極 の代わりに不透明陽極を使用することである。

【0019】有機EL装置200及び300を共に見比 べれば、本発明がプラス又はマイナス極性何れの不透明 支持体上に装置を配置するかの選択を提供することが明 白である。本発明によるEL装置の有機ルミネセンス媒 体は2つの分離した有機層を包含しており、1層は装置 の電子注入及び移動領域を形成し、もう1層は正孔注入

【0020】本発明によるEL装置の好ましい具体例は **最低で3つの分離した有機層を包含し、そのうち少なく** とも1層が装置の電子注入及び移動領域を形成し、少な くとも2層が正孔注人及び移動領域を形成し、後者の領 域の1層は正孔注入領域を提供し残りの層は正孔移動領 域を提供する。ポルフィリン系化合物を含有する1層が 有機EL装置の正孔注入領域を形成する。ポルフィリン 系化合物とは、ポルフィリン構造から誘導された又はポ ルフィリン構造を含有する天然又は合成化合物の全てを* * 指し、ポルフィリン自体をも含むものである。本願にお いて引用されるアドラー(Adler)の米国特許第3935 031号又はタンの米国特許第4356429号におい て開示されたうち全てのポルフィリン系化合物を使用す ることが可能である好ましいポルフィリン系化合物は以 下の構造式を有している。

[0021]

【化3】

[0022] (式中、Qは-N=又は-C (R) =であ り、Mは金属、金属酸化物又は金属ハロゲン化物であ り、Rは水素、アルキル、アラルキル、アリール又はア ルカリルであり、T¹及びT²は水素、又は両者が共に なったアルキル若しくはハロゲン等の置換基を含有する ことのできる不飽和六韻環(6 memeber ring)である)。 好ましい六韻環は炭素、硫黄及び窒素原子により構成さ れるものである。好ましいアルキル部分は約1から6の 炭素原子を含有し、一方、フェニル基は好ましいアリー

【0023】2つの水素原子を金属原子により置換した ことによって構造式(I)のポルフィリン化合物とは相 違する他の好ましいポルフィリン化合物の形態は式(I 1) により示される。

[0024]

ル部分を構成する。

【化4】

(II)

【0025】非常に好ましい有益なポルフィリン化合物 の例は、脱金属フタロシアニン及び金属含有フタロシア タロシアニンが特に、全ての金属を含有することができ る一方で、その金属原子が2又はそれ以上のプラスの原 子価を有していることが好ましい。好ましい金属の例は コパルト、マグネシウム、亜鉛、パラジウム、ニッケ ル、そして特に銅、鉛及びプラチナである。

(I)

【0026】有益なポルフィリン系化合物の例は以下の 通りである。

PC-1: ポルフィン

PC-2: 1,10,15,20- テトラフェニル -21H,23H-ポル 30 フィン銅(II)

PC-3: 1,10,15,20- テトラフェニル -21H,23H-ポル フィン亜鉛(II)

PC-4: 5,10,15,20- テトラキス (ペンタフロロフェ ニル)-21H. 23H-ポルフィン

P C-5: 硅素フタロシアニンオキシド

P C-6: アルミニウムフタロシアニンクロリド

P C-7: フタロシアニン (脱金属)

PC-8: 銅テトラメチルフタロシアニン

PC-10: 銅フタロシアニン

40 PC-11: クロムフタロシアニンフロリド

PC-12: 亜鉛フタロシアニン

PC-13: 鉛フタロシアニン

PC-14: チタンフタロシアニン

PC-15: マグネシウムフタロシアニン

PC-16: 銅オクタメチルフタロシアニン

有機EL装置の正孔移動層は少なくとも1つの正孔移動 芳香族第三アミンを含有しており、後者は炭素原子のみ (そのうちの少なくとも1つが芳香環の構成原子であ る) に結合している少なくとも1つの三価の窒素原子を ニンである。ポルフィリン系化合物が一般に、そしてフ 50 含有すると理解される。1つの形態において、芳香族第

-319-

Q

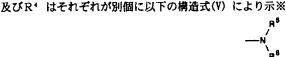
三アミンはモノアリールアミン、ジアリールアミン、トリアリールアミン又はアリールアミン重合体等のアリールアミンであることができる。モノマー系のトリアリールアミンの例はクラッフェル(Klupfel)等の米国特許第3180730号に説明されている。ビニル基又はビニルラジカルにより置換された及び/又は少なくとも1つの活性水素原子を含む群を含有する他の適したトリアリールアミンはブラントリー(Brantley)等の米国特許第3567450号及び第3658520号に開示されている

【0027】 芳香族第三アミンの他のクラスは、少なく とも2つの芳香族第三アミン部分を包含するものであ る。かかる化合物は構造式(III) により示されるものを 含む。

[0028]



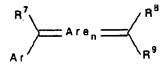
【0031】 (式中、R¹ 及びR² はそれぞれ別個に水 素原子、アリール基又はアルキル基を、 或いはR¹ 及 びR² 双方が共になってシクロアルキル基を表し、R³



(V)

【0033】 (式中、R⁶ R⁶ は独立して選択されるアリール基である。)

芳香族第三アミンの他のこのましいクラスはテトラアリールアミンである。好ましいテトラアリールアミンは、アリーレン基を通して結合された式(v) によって示され★



【0035】(式中、Areはアリーレン基であり、nは 1から4までの整数であり、Ar、 R^7 、 R^8 及び R^9 は独立して選択されるアリール基である。)

前述した構造式(III),(IV),(V)の様々なアルキル、アルキレン、アリール及びアリーレン基のそれぞれを置換することが可能である。典型的な置換基としてはアルキル基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基並びにフッ案、塩素及び臭素等のハロゲンが含まれる。様々なアルキル及びアルキレン部分は典型的に約1から6の

* [125]

(III)

【0029】(式中、Q¹ 及びQ² は独立して芳香族アミン部分であり、Gは炭素-炭素結合を有するアリーレン、シクロアルキレン又はアルキレン等のリンク基である。)

10

10 構造式(III) を満足させると共に2つのトリアリールア ミン部分を含有する好ましいトリアリールアミンのクラ スは以下の構造式(IV)を満足させるものである。

[0030] [化6]

※されるジアリール置換されたアミノ基によって置換され たアリール基を表す。

(VI)

【0032】 【化7】

★るような2つのジアリールアミノ基を含有する。好ましいテトラアリールジアミンは式(VI)によって表されるものを包含する。

[0034]

【化8】

(VI)

炭素原子を含んでいる。シクロアルキル部分は3から約10の炭素原子を含有することができるが、例えばシクロペンチル、シクロヘキシル及びシクロヘプチル環構造といった5、6又は7の炭素原子を典型的に有している。アリール及びアリーレン部分は、フェニル及びフェニレン部分であることが好ましい。

基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基並び 【0036】有機エレクトロルミネセンス媒体の正孔移 にフッ素、塩素及び臭素等のハロゲンが含まれる。様々 動層全体が単一の芳香族第三アミンによっても形成する なアルキル及びアルキレン部分は典型的に約1から6の 50 ことができる一方で、芳香族第三アミンの組み合わせを

用いることにより安定性を増加することができるという ことが本発明の更なる認識である。特に、以下の実施例 において証明されるとおり、式(IV)を満足するようなト リアリールアミンを式(VI)に示されるようなテトラアリ ールジアミンと組み合わせることが有益であることが観 察された。トリアリールアミンをテトラアリールジアミ ンと組み合わせて使用する際には、後者をトリアリール アミンと電子注入及び移動層との間に介在する層として 配置する。

願において引用するパーウィック(Berwick) 等の米国特 許第4175960号及びファンスライク等の米国特許 第4539507号に開示されている。パーウィック等 は更に、有益な正孔移動化合物として、上に示したジア リール及びトリアリールアミンの環架橋変化体として見 ることもできるN置換カルパゾールを開示している。有 益な芳香族第三アミンの例には以下のものがある。

【0038】1,1-ピス(4-ジ-p-トリルアミノフェニ ル)シクロヘキサン

1,1-ピス(4-ジ-p-トリルアミノフェニル)-4-フェニル 20 シクロヘキサン

4.4'- ピス(ジフェニルアミノ)クアドリフェニル ピス(4-ジメチルアミノ-2-メチルフェニル)-フェニル メタン

N. N. N-トリ(p-トリル) アミン

4-(ジ- p-トリルアミノ)-4'- 4(ジ- p-トリルアミノ)-スチリル スチルペン

N, N, N', N'-テトラ-p-トリル-4-4'-ジアミノビフェニル N. N. N'. N'-テトラフェニル-4.4'-ジアミノビフェニル N-フェニルカルパゾール

12

*ポリ(N-ピニルカルバゾール)

有機EL装置の性能を左右する重要な点は、有機薄膜層 の形態的安定性にかかっている。有機薄膜の無定形状態 から結晶状態又は準結晶状態、或いは一つの結晶状態か ら他の結晶状態への転移は薄膜の物理的又は形態的変化 に帰結することがある。この転移は一般的に温度に依存 するものである。無定形状態から結晶状態への転移温度 はガラス転移温度Tgとして知られている。本発明に説 明される有機EL装置の成功は、エレクトロルミネセン 【0037】有益な芳香族第三アミンの代表例は、本出 10 スの発生に起因する電子及び正孔移動特性及びそれらの 組み合わせ効率が有機層のミクロレベルにおける構造に 大きく依存するという理由から上記の形態的変化に対し て敏感である。例えば、漸進的な形態的変化の結果とし TEL効率が減少すると、エレクトロルミネセンス出力 もまた着実に減少しEL装置の有益性を制限することに なる。より深刻な場合には、EL構造中の有機層の破壊 並びに陽極及び陰極コンダクター間の電気的ショートに より悲劇的な結果となる。それ故、EL装置を形成する 全ての有機層は、原則的に、可能な限り高いガラス転移 温度を有すべきであり、最も低いTgを有する層がEL 装置全体の安定性を制限する場合が多いということが認 識されている。特に、上述したように、正孔移動層に用 いられるアミンが、一般的にこのクラスの物質に付随す る例えば100℃未満の低いTgの故にEL構造におけ る最も不安定な成分を形成する。EL装置において通常 使用される幾つかの芳香族アミンの分子式をそれらのT gと共に以下に示す。

分子構造

Tg (℃)

[0039]

* 30 【化9】

[0040]

【化10】

[0041] (化11)

60

(8)

【0042】本発明は有機EL装置に特に有用な高いガラス転移温度を有するポリ置換アニリノベンゼンの新規なクラスを開示するものである。その分子式は、*

* [0043] 【化12】

【0044】 (式中、R'及びR'はアルキル、アリール又は置換アリール基の何れかであり、Rは水素、アルキル、フェニル又は置換フェニル基であり、nは3、※

[0047]

※4、5又は6である)を包含する。高いTgを有するポリ関換アニリノベンゼンの例は以下の通りである。

(化合物 分子構造 Tg(C)

(10046]

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(10046)

(1

【化15】

特開平8-259940

16

15

3

135 *【化16】

[0048]

· 165

化合物 [0049] 分子構造 ※【化17】 *

5

[0050]

【化18】

17

化合物 【0051】 分子構造

*【化19】

[0052]

※ ※ 【化20】

化合物 【0053】 分子構造

【化21】

19

9

化合物 【0054】

【化22】

i0

分子構造

[0055] [化23]

11

化合物

[0056] {化24]

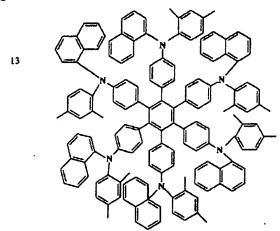
12

20

30

分子構造

【0057】 【化25】



【0058】本発明における有機EL装置の電子注入及 び移動層を形成するの好ましい薄膜形成物質は、オキシ ン (8-キノリノール又は8-ヒドロキシキノリンとも 呼ばれる) 自体のキレートをも含む金属キレートオキシ ノイド(oxinoid) 化合物である。かかる化合物は高レベ*



【0060】(式中、Mは金属を表し、nは1から3の 整数であり、2は独立してそれぞれの場合において、少 なくとも2つの縮合芳香環を有する1つの核を完成させ る原子(複数)を表す。)

前の記述からかかる金属は一価、二価又は三価の金属で あることができることは明白である。例えば、かかる金 30 属はリチウム、ナトリウム又はカリウム等のアルカリ金 属、マグネシウム又はカルシウム等のアルカリ土類金 属、或いはホウ素又はアルミニウム等の土類金属である ことができる。一般的に、キレート金属として有益であ ることが知られている全ての一価、二価又は三価の金属 を使用することが可能である。

【0061】 2はそのうちの少なくとも1つがアゾール 又はアジン環である少なくとも2つの芳香環を含有する 複素環の核を完成する。脂肪環及び芳香環の双方を含む 追加環はもし必要ならば前配の2つの環と縮合させても 40 k.a,ピス(5-クロロ-8-キノリノラート)カルシウ よい。機能を向上させることなく分子パルクを加えるこ とを避けるために、環原子の数は18以下に維持するこ とが好ましい。

【0062】有益なキレートオキシノイド化合物の例は 以下の通りである。

CO-1: アルミニウムトリスオキシン [a.k.a,トリス (8-キノリノラート) アルミニウム]

CO-2: マグネシウムピスオキシン [a.k.a, ピス (8 ーキノリノラート) マグネシウム]

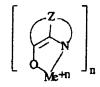
CO-3: ピス [ベンゾ (f) -8-キノリノラート]

*ルの性能を有し薄膜形状にも容易に加工することができ る。意図するオキシノイド化合物の例は、構造式(VII) を満足させるものである。

22

[0059]

【化26】



(VII)

催重

CO-4: ピス (2-メチル-8- キノリノラート) アル ミニウム (III) - μ - オキソーピス (2 - メチル-8 -キノリノラート)アルミニウム(III)

CO-5: インジウムトリスオキシン [a.k.a,トリス (8-キノリノラート) インジウム]

CO-6: アルミニウムトリス (5-メチルオキシン) [a.k.a, トリス (5-メチル-8-キノリノラート) ア ルミニウム]

CO-7: リチウムオキシン (a.k.a., 8-キノリノラ ート リチウム)

CO-8: ガリウムトリス(5-クロロオキシン) [a. k.a, トリス(5-クロロ-8-キノリノラート) ガリウ ム]

CO-9: カルシウムピス(5-クロロオキシン) [a.

CO-10: ポリ [亜鉛(II)-ピス (8-ヒドロキシ-5 -キノリニル) メタン]

CO-11: ジリチウムエピンドリジオン(dilithium epi ndolidione)

CO-12: UX(2-x+y-8-4y)(パラーフェニルフェニラート) アルミニウム(III)

本発明の有機EL装置において、有機ルミネセンス媒体 の総厚を1mm(10000オングストローム)未満に 50 制限することによって両電極間の電圧を比較的低くする

一方で、効果的な発光に適合した電流密度を保つことが 可能である。1mm未満厚さにおいて20ポルトの電圧 を加えると、効果的な発光に適合する2×105 ポルト /cmより大きなフィールドポテンシャルが生じる。有 機ルミネセンス媒体の厚さにおける1オーダー規模の減 少 (0. 1mm又は100オングストローム) は、加え る電圧の更なる減少及び/又はフィールドポテンシャル つまりは電流密度の増加を許容し、それは十分に装置構 造性能の範囲内である。

能は、EL装置の電気的パイアスに電極のショートを防 ぐ誘電パリアを提供することである。有機ルミネセンス 媒体中にただ1つのピンホールがあるだけでショートの 原因となる。例えばアントラセンといった単一の高度に 結晶化されたルミネセンス物質を用いる従来のEL装置 とは違い、本発明のEL装置はショートしない非常に薄 い総合厚の有機ルミネセンス媒体を製造することが可能 である。その1つの理由は、3つの積層の存在が両電極 間に連続した導電路を提供するピンホールが層に発生す る機会を大幅に減少するということである。このことは 20 それ自体において、許容できる範囲のEL装置機能及び 信頼性を達成しながら、有機ルミネセンス媒体の1つ又 は2つの層でさえ被覆時において膜形成には理想的でな い物質によって形成することを可能にするものである。

【0064】有機ルミネセンス媒体を形成するのに好ま しい物質はそれぞれ薄膜形態に製造可能なもの、つま り、0.5mm又は5000オングストローム未満の厚 さの連続した層に製造可能なものである。1つ又はそれ 以上の有機ルミネセンス媒体の層が溶媒被覆された場合 に、ピンホール等の構造的欠陥のない連続層を得ること 30 を確実にするために膜形成ポリマーパインダーを活性物 質と共通堆積(codeposite)させることができる。パイン ダーを使用する場合には、勿論それ自体高い誘電強度を 有していなくてはならず、それは少なくとも約2×10 6 ポルト/cmであることが好ましい。適したポリマー は広範囲の既知のキャストアディション(cast additio n) 及び縮合ポリマーから選択することが可能である。 適した縮合ポリマーの例はポリエステル、ポリカルポネ ート、ポリイミド及びポリスルフォンである。活性物質 の不必要な希釈を避けるためにパインダーの量は層を形 40 成する物質の総重量を基として50重量パーセント未満 に制限することが好ましい。

【0065】有機ルミネセンス媒体を形成する好ましい 活性物質は、膜形成物質であって真空めっき蒸着の可能 なものである。真空めっき蒸着により非常に薄い欠陥の ない連続層を生成することが可能である。特に、満足で きるEL装置性能を実現させながら、個々の層の厚さを 約50オングストロームの薄さにすることが可能であ る。真空めっき蒸着させたポルフィリン系化合物を正孔 注入層として、膜形成芳香族第三アミンを正孔移動層

24

(それはトリアリールアミン層及びテトラアリールジア ミン層であることができる)として、キレートオキシノ イド化合物を電子注入及び移動層として用いることによ り、約50から5000オングストロームの範囲の個々 の層の厚さを予期することができ、100から2000 オングストロームの範囲の層厚であることが好ましい。 一般的には有機ルミネセンス媒体の総厚が少なくとも約 1000オングストロームであることが好ましい。

【0066】有機EL装置の陽極及び陰極は、従来の都 【0063】有機ルミネセンス媒体が遂行する1つの機 10 合のよい全ての形態をとることが可能である。陽極を通 して有機EL装置から発光させることを意図する場合に は、例えば透明又は実質的に透明なガラスプレート又は プラスチックフィルムの光透過性担体上に薄い導電性層 を被覆することによってそれを達成することができる。 本発明の有機EL装置の1つの形態においては、上述し たガーニー等の米国特許第3172862号、ガーニー の米国特許第3173050号、ドレスナーの"Double Injection Electroluminescence in Anthracene", RCA R eview, Volume30, 322-334 頁, 1969、及びドレスナー の米国特許第3710167号に開示されたガラスプレ ート上に被覆された錫酸化物又はインジウム錫酸化物に より形成された光透過性陽極を含む歴史的実践を迫うこ とも可能である。全ての光透過性ポリマーフィルムを担 体として使用することができる一方で、ギルソン(Gills on) の米国特許第2733367号及びスインデルズ(S windells) の米国特許第29411104号はこの目的 のために特に選択されたポリマーフィルムを開示してい

> 【0067】本明細書中に用いられる「光透過性」と は、当の層又は素子がそれが受け取る波長のうちの少な くとも1つの光の50パーセント以上を、好ましくは少 なくとも100nm以上のインターパルで透過すること を意味する。反射(非拡散)及び散漫(拡散)双方の発 光は所望される装置の出力であるので、半透明及び透明 の双方又は実質的に透明な物質は有益である。また殆ど の場合において、有機EL装置の光透過性層又は素子は 無色又は中性の光学濃度であり、つまり他と比較して1 つの波長範囲において顕著に高い光吸収を示さない。し かしながら、光透過性電極担体又は分離積膜又は素子 は、勿論、もし所望されるならば光トリミングフィルタ ーとして機能するようにその光吸収特性を適応させるこ とが可能である。かかる電極の製造は、例えば、フレミ ング(Fleming) の米国特許第4035686号に開示さ れている。受け取る波長又は波長の倍数に近い厚さに製 造された電極の光透過性導伝層は干渉フィルターとして 機能することができる。

【0068】歴史的経緯とは反対に、好ましい1つの形 態において本発明の有機EL装置は陽極よりはむしろ陰 極を通して光を発する。このことは陽極が光透過性であ 50 ることに対するいかなる要求をも取り除いてしまう。実

際、本発明のこの形態においてそれは光に対して不透明であることが好ましい。不透明陽極は、陽極製造に対して適切な高い仕事関数を有する全ての金属又は金属の組み合わせにより形成することが可能である。好ましい陽極金属は4電子ポルト(e V)より大きい仕事関数を有している。適切な陽極用金属は以下に羅列される高(>4 e V)仕事関数金属の中から選択することができる。不透明陽極を担体上の不透明金属層或いは分離金属ホイル又はシートとして形成することが可能である。

【0069】本発明による有機EL装置は、この目的の 10 為に前に有益であると教示した全ての高又は低仕事関数 金属を含む全ての金属により形成された陰極を使用する ことができる。低仕事関数金属の組み合わせ及び少なく とも他の1つの金属により陰極を形成することにより、 予期せぬ製造、性能及び安定性における有益性が実現さ*

*れた。更なる開示に関しては本明細書に引用されるタン 及びファンスライクによる米国特許第4885211号 を参照されたい。

26

[0070]

【実施例】本発明及びその有益性は以下の明確な実施例により更に説明される。「Tg」とは、TAインスツルメント(TA Insutrument)により製造された市販のモデル912DSCを用いた熱グラフ分析により測定されたガラス転移温度を摂氏で示すものである。

10 合成

高Tgポリ置換アニリノベンゼンの一般的調製方法は以下の通りである。

[0071]

【化27】.

A:

[0072]

【化28】

B:

※ [0073] (化29]

【0074】例1:1,3,5-トリス-4-(ジフェニルアミ ノ)フェニルベンゼンの合成

(化合物 1) 塩化硅素(IV)(0.58 ml, 0.85 g, 0.005 mo l)を攪拌されている 2 0 mlのドライエタノール中の4' - ジフェニルアミノアセトフェノン(1.43 g, 0.005 mo

1) 懸濁液に室温でシリンジを用いてゆっくりと加えた。混合物を一晩攪拌した後、還流しながら1時間加熱した。反応混合物を水に注ぎ、生じた沈殿物をろ過した。粗縮合物を1:1ヘキサン/ジクロロメタンを溶解50 液として使用してシリカゲル上でクロマトグラフにか

け、純粋な1,3,5-トリス-4-(ジフェニルアミノ) フェニ ルベンゼン(160 mg)を12%の収率で得た。

例2:1,3,5-トリス-4-(ジ-p- トリルアミノ) フェニル ベンゼンの合成

(化合物2) 塩化硅素(IV)(12.0 ml, 17.0 g, 0.10 mo 1) を攪拌されている50mlのドライエタノール中の 4'- ジ-p- トリルアミノアセトフェノン(16.0 g, 0.005 mol) 懸濁液に室温でシリンジを用いてゆっくりと加え た。混合物を室温で1時間攪拌した後、還流しながら一 過した。粗縮合物を1:1ヘキサン/ジクロロメタンを 溶離液として使用してシリカゲル上でクロマトグラフに かけ、純粋な1,3,5-トリス-4-(ジ-p- トリルアミノ)フ ェニルベンゼン(6.5 四)を44%の収率で得た。

例3:1,3,5-トリス-4-(N-フェニル)(N-2-ナフタレニ ル) アミノフェニルベンゼンの合成

(化合物3) 50mlのドライエタノール中の4'-N-(2 - ナフタレニル)-N-(4- アセトフェニル) アニリン(3.0 g. 0.0089 mol) を均一な溶液になるまで還流した。こ 室温でシリンジを用いてゆっくりと加えた。溶液は瞬時 に深緑色に変わった。この混合物を室温で1時間攪拌し た後、還流しながら一晩加熱した。反応混合物からは大 量の固体が沈殿し、反応溶液の色はより薄くなった。反 応混合物を室温まで冷やし、100mlの水を加え、生 じた沈殿物をろ過した。粗縮合物をオープンで乾燥させ 100mlのジクロロメタンに添加した。30分間の攪 拌の後、沈殿物をろ過し約100mlのジクロロメタン で洗った。有機溶液を収集し溶媒を除去した。残留物を 4:1リグロイン/ジクロロメタンを溶解液として使用 30 してシリカゲル上でクロマトグラフにかけ、純粋な1,3, 5-トリス- 4-(N- フェニル)(N-2-ナフタレニル) アミノ フェニルペンゼン(1.86 g)を65.5%の収率で得た。 例4:1,3,5-トリス-4-(N-1-ナフタレニル)(N-2-ナフ タレニル) アミノフェニルペンゼンの合成

(化合物 4) 塩化硅素(IV)(2.5 ml, 3.7 g, 0.022 mol) を機幹されている10mlのドライエタノール中の4'-N-(1- ナフタレニル)-N-(2- ナフタレニル) アミノアセ トフェノン(1.94 g. 0.005 mol) 懸濁液に室温でシリン ジを用いてゆっくりと加えた。溶液は瞬時に深緑色に変 40 わった。この反応溶液窒素下で還流しながら3時間加熱 した。反応混合物を室温まで冷やし、更に1.0mlの 塩化硅素を加えた。反応混合物を更に1時間還流しなが ら加熱した。溶媒を除去し残留物をジクロロメタンに溶 解させ水で洗った。溶媒を取り除いた後、粗縮合物を 2:1ヘキサン/ジクロロメタンを溶離液として使用し てシリカゲル上でクロマトグラフにかけ、純粋な1,3,5-トリス- 4-(N-1- ナフタレニル)(N-2-ナフタレニル)ア ミノフェニルベンゼン(0.98 mg) を53.1%の収率で 得た。

例 5 : ピス 4-(ジ- p-トリアリールアミノ) フェニル] アセチレンの合成

4 0 m L の ドライ T H F 中 の 4 - プロモーN, N - (ジ-p- トリ ル) アニリン(5.02 g, 14.3 mmol) 、ピス(トリ-n- プ チルスタニル) アセチレン(4.6 g, 7.6 mmol)及びテト ラキス (トリフェニルホスフィノ)-パラジウム(360 mg, 4 %mol)の混合物を窒素下で2 4時間還流した。減圧に より溶媒を除去し100mLのNaOH(1M)を加え 混合物を20分間超音波処理した。沈殿した赤色固体を 晩加熱した。反応混合物を水に注ぎ、生じた沈殿物をろ 10 ろ過し水で洗い乾燥した。粗生成物を酢酸エチルと共に 粉末にし、その後の反応に適した生成物2.6g(64 %) を得た。分析用サンプルはブチロニトリルとの再結 晶により得ることができる。Cr2 H36 N2 の分析:計算 上はC,88.69、H,6.38 、N,4.93 、実際はC,87.84、 $H, 5.40 \ N, 5.06$

> 例6: ヘキサ 4-(ジ- p-トリアリールアミノ) フェニ ル] アセチレンの合成

40mLのドライTHF中の上記のアセチレン化合物及 び200mgのオクタカルポニルニコパルトを窒素下で の溶液に塩化硅素(IV)(10.0 ml, 14.8 g, 0.087 mol)を 20 4 8 時間還流した。溶媒を除去した後、ヘキサン/メチ レンクロリド(3/1) を溶離液として用いて3/4"×5"のシ リカゲル(32-63ミクロン) コラムによりフラッシュクロ マトグラフにかけ、僅かに黄を帯た茶色の固体(1.78 g) を得た。この生成物をヘキサンを使用したソックスレー 抽出により更に精製し色を除去した。金属筒の残留物は 1. 3g(収率65%)の重さの純粋な生成物であっ た。C126 H108 N6 の分析:計算上はC,88.69、H, 6.38、N,4.93、実際はC,88.28、H,6.49、N,4.83 $\cdot \cdot H - NMR \quad (CDC1_3) : d2.27(s), 6.70(s), 6.8$ 9(d, j = 8.2 Hz), 7.0(d, j = 8.1 Hz); ¹³ C - NMR (CDCl₃): d20.74, 121.96, 123.95, 129.76, 131.62, 132. 39, 135. 16, 140. 11, 145. 29, 145. 60 ppm.

EL装置作成及び性能

例7:高丁g正孔移動層を有するエレクトロルミネセン ス装置

本発明の要求を満足するエレクトロルミネセンス装置は 以下の方法により製造された。

【0075】a) インジウム-錫-オキシド被覆された ガラス担体を市販されている洗剤中で超音波処理し、脱 イオン水で濯ぎ、トルエン蒸気中で脱脂し、紫外線及び オゾンに数分間晒した。

b) フタロシアニン銅の正孔注入層(150オングスト ローム)をタンタルポートからの蒸発によりITO被覆 した担体上に堆積させた。

【0076】c) CuPc層の上に1,3,5-トリス-4-(ジ -p- トリルアミノ)フェニルペンゼンの正孔移動層を再 びタンタルポートからの蒸発により堆積させた。

d) 次に、トリス(8-キノリノラート) アルミニウム(I 11)(600オングストローム)の発光層を正孔移動層の 50 上に堆積させた。この物質もまたタンタルポートから蒸 '-

発させた。

【0077】e) 10:1原子比のMg及びAgにより 形成された2000陰極をAlO₃層の上に堆積させ た。

29

このように形成したエレクトロルミネセンスセルの安定性の試験を20mA/cm²の一定電流を用いて行った。最初の明るさは0.72mW/cm²であり、これは表示用途に要求されるレベルを十分に上回っていた。このセルの強度は除々に減少し、250時間の連続使用の後に50%の減少となった。これは高レベルの光出力10の持続を証明するものである。

<u>例8</u>: 高Tg正孔移動層を有するエレクトロルミネセンス装置の更なる例

正孔移動層が1,3,5-トリス-4-(N-1-ナフタレニル)(N-2-ナフタレニル) アミノフェニルベンゼン (600オングストローム) であることを除いては例1と同様にE1セルを製造した。そのように製造した装置を例1の装置と同じ条件下で操作したところ、0.62mW/cm²の初期の明るさを示し、それは約200時間の操作の後に半分のレベルになった。この例もまた高レベルの光出 20カの持続を証明するものである。

【0078】本発明をその好ましい具体例を参照して詳細に説明したが、本発明の趣旨及び範囲内において様々な変形及び改良を行うことができることは理解されるこ

とである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるエレクトロルミネセンス装置10 0の概略説明図である。

30

【図2】本発明によるエレクトロルミネセンス装置20 0の概略図である。

【図3】本発明によるエレクトロルミネセンス装置30 0の機略図である。

【符号の説明】

10 100、200、300 EL装置

102、204、302 陽極

104、214、314 陰極

106、206、306 有機ルミネセンス媒体

108、110、112 積層

114 外部電源

116、118 コンダクター

120 下側有機層

122 上側有機層

124 正孔

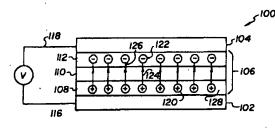
126 電子

128 端

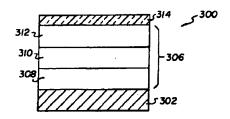
202 透明絶縁性担体

208、210、212、308、310、312 層

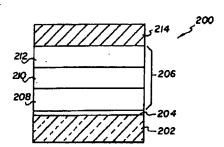
【図1】



【図3】



[図2]



フロントページの続き

(72)発明者 スティーヴン エイ ヴァン スライク アメリカ合衆国, ニューヨーク 14625, ロチェスター, コリングスワース・ドライ ヴ 39 (72)発明者 チン ダブリュ タン アメリカ合衆国, ニューヨーク 14625, ロチェスター, パーク・レーン 176